



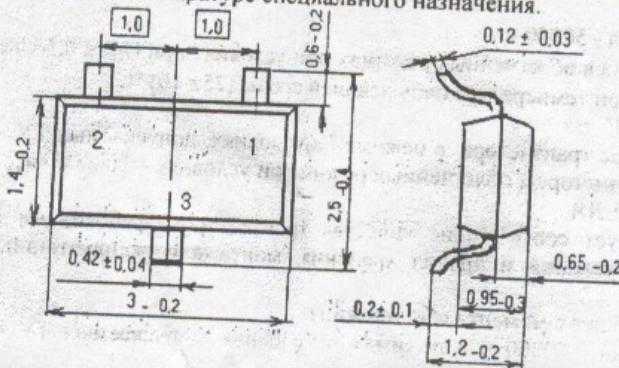
Транзисторы

2П308А9, 2П308Б9, 2П308В9,
2П308Г9, 2П308Д9, 2П308Е9

Код ОКП 63 4100

ЭТИКЕТКА ЩЫЗ.365.072 ЭТ

Кремниевые эпитаксиально - планарные полевые п-канальные усиливательные транзисторы типов: 2П308А9, 2П308Б9, 2П308В9, 2П308Г9, 2П308Д9, 2П308Е9 в миниатюрном пластмассовом корпусе, требующие дополнительных мер индивидуальной или общей защиты в составе аппаратуры от воздействия климатических и биологических факторов и предназначенные для работы в аппаратуре специального назначения.



1 - сток, 2 - исток, 3 - затвор.

Тип транзистора обозначается кодом «5», группа - соответствующей буквой.
Масса - не более 0,01г

1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.2 Основные электрические параметры при $t_{amb} = (25 \pm 10)^\circ\text{C}$

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		не менее	не более
Ток утечки затвора ($U_{DS} = 0 \text{ В}$, $U_{GS} = -10 \text{ В}$), мкА	I_{GSS}		1×10^{-3}
Ток утечки затвора ($U_{DS} = 0 \text{ В}$, $U_{GS} = -30 \text{ В}$), мкА	I_{GSS}		10
Начальный ток стока ($U_{DS} = 10 \text{ В}$, $U_{GS} = 0 \text{ В}$), мА 2П308А9 2П308Б9 2П308В9 2П308Е9	I_{DSS}	0,4 0,8 1,4 2,8	1,0 1,6 3,0 6,0
Напряжение отсечки ($U_{DS} = 10 \text{ В}$, $I_D = 10^{-3} \text{ мА}$), В 2П308А9 2П308Б9 2П308В9 2П308Г9 2П308Д9 2П308Е9	U_{GSoff}	0,2 0,3 0,4 1,0 1,0 0,2	1,2 1,8 2,4 6,0 3,0 6,0
Активная составляющая выходной проводимости ($U_{DS} = 10 \text{ В}$, $U_{GS} = 0 \text{ В}$, $f = (50 - 1500 \text{ Гц})$, мкСм, 2П308А9 2П308Б9, 2П308В9)	g_{22s}		10 20
Крутизна характеристики ($U_{DS} = 10 \text{ В}$, $U_{GS} = 0 \text{ В}$, $f = (50 + 1500 \text{ Гц})$, мА/В 2П308А9, 2П308Б9 2П308В9 2П308Е9	g_{ms}	1,0 2,0 1,0	4,0 5,0

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		не менее	не более
Электродвижущая сила шума ($U_{DS} = 10V$, $U_{GS} = 0V$, $f = 10^3$ Гц), нВ / $\sqrt{Гц}$, 2П308А9, 2П308Б9, 2П308В9	e _n		20
Сопротивление сток-исток в открытом состоянии ($U_{DS} = 0,2$ В, $U_{GS} = 0$ В), Ом 2П308Г9 2П308Д9	$r_{DS(on)}$	230	250 500

1.2 Содержание драгоценных металлов в одном транзисторе:
золото - 0,0400 мг, серебро - 0,1441 мг, палладий - 0,0009 мг.

1.3 Содержание цветных металлов и их сплавов в одном транзисторе:
Цветных металлов не содержится.

2 НАДЕЖНОСТЬ

2.1 Минимальная наработка - 50000 ч.

Минимальная наработка в облегченных режимах при условиях при $U_{DS} \leq 0,5 U_{DS\ max}$.
 $P_{DS} \leq 0,5 P_{DS\ max}$ - 100000 ч при температуре окружающей среды (25 ± 10) °C.

2.2 Срок сохраняемости - 25 лет.

2.3 95 - процентный ресурс транзистора в режимах и условиях, допускаемых ТУ - не менее 100000 часов.

95 - процентный ресурс транзистора в облегченных режимах и условиях - 200000 часов.

3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества транзисторов требованиям аАО.339.618 ТУ при соблюдении потребителем условий и правил хранения, монтажа и эксплуатации, приведенных в ТУ на изделия.

Гарантийный срок - 25 лет с момента изготовления.

Гарантийная наработка - 50000 ч в режимах и условиях, допускаемых ТУ в пределах гарантийного срока.

Изготовитель гарантирует стойкость транзистора к воздействию специальных факторов с характеристиками И8-И11 до максимальных уровней.

Устойчивость к воздействию акустического шума гарантировается конструкцией транзистора.

4 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Транзисторы 2П308А9, 2П308Б9, 2П308В9, 2П308Г9, 2П308Д9, 2П308Е9 соответствуют техническим условиям аАО.339.618 ТУ и признаны годными для эксплуатации.

Приняты по извещению № 5 от 22.07.05г.

(дата)

Место для штампа ОТК

Место для штампа
Представителя заказчика

25.00

Место для штампа «Перепроверка произведена

(дата)

Приняты по извещению № 7 от 5.09.08г.

(дата)

Место для штампа ОТК

Место для штампа
Представителя заказчика

25.00

Цена договорная

ПРИБОРЫ
ПЕРЕПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 5.09.04

5 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1 Применение транзистора в функциональных схемах, режимах и условиях, отличных от требований ТУ, должно быть согласовано в соответствии с ГОСТ 2.124-85 и ОСТ 11.336.907.0-79.

5.2 Не допускается использование транзисторов более чем в двух совмещенных предельных режимах, не рекомендуется также совмещение предельных температурных и электрических режимов.